

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/001868

International filing date: 02 February 2005 (02.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-027996
Filing date: 04 February 2004 (04.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 24 March 2005 (24.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

02. 2. 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日 2004年 2月 4日
Date of Application:

出願番号 特願2004-027996
Application Number:
[ST. 10/C] : [JP2004-027996]

出願人 大阪瓦斯株式会社
Applicant(s):

2005年 3月 10日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川

洋

【書類名】 特許願
【整理番号】 8512003JP
【提出日】 平成16年 2月 4日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 C08L101/00
【発明者】
 【住所又は居所】 京都府京都市下京区中堂寺南町134 株式会社K R I 内
 【氏名】 山口 浩一
【発明者】
 【住所又は居所】 京都府京都市下京区中堂寺南町134 株式会社K R I 内
 【氏名】 羽山 秀和
【発明者】
 【住所又は居所】 京都府京都市下京区中堂寺南町134 株式会社K R I 内
 【氏名】 孫 仁徳
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内
 【氏名】 山田 昌宏
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内
 【氏名】 西野 仁
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内
 【氏名】 横道 泰典
【特許出願人】
 【識別番号】 000000284
 【氏名又は名称】 大阪瓦斯株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100065215
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 三枝 英二
 【電話番号】 06-6203-0941
【選任した代理人】
 【識別番号】 100076510
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 掛樋 悠路
【選任した代理人】
 【識別番号】 100086427
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 小原 健志
【選任した代理人】
 【識別番号】 100099988
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 斎藤 健治
【選任した代理人】
 【識別番号】 100105821
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 藤井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100099911

【弁理士】

【氏名又は名称】 関 仁士

【選任した代理人】

【識別番号】 100108084

【弁理士】

【氏名又は名称】 中野 瞳子

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001616

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0313844

【書類名】特許請求の範囲**【請求項1】**

熱可塑性樹脂及び熱硬化性樹脂から選ばれた少なくとも1種の樹脂及びナノスケールカーボンチューブを含有し、ナノスケールカーボンチューブが上記樹脂を基準として0.001～0.4重量%の割合で含有されていることを特徴とするG H z帯域電子部品用樹脂組成物。

【請求項2】

ナノスケールカーボンチューブが、

- (i) 単層カーボンナノチューブ又は入れ子構造の多層カーボンナノチューブ、
- (ii) アモルファスナノスケールカーボンチューブ、
- (iii) ナノフレークカーボンチューブ、
- (iv) (a)ナノフレークカーボンチューブ及び入れ子構造の多層カーボンナノチューブからなるカーボンチューブと、(b)炭化鉄又は鉄とからなり、該カーボンチューブ(a)のチューブ内空間部の10～90%の範囲に、該炭化鉄又は鉄(b)が存在している鉄一炭素複合体、又は
- (v) 上記(i)～(iv)の2種以上の混合物

であることを特徴とする請求項1に記載のG H z帯域電子部品用樹脂組成物。

【請求項3】

ナノスケールカーボンチューブが、アモルファスナノスケールカーボンチューブであって、X線回折法（入射X線：Cu K α ）において、ディフラクトメーター法により測定される炭素網平面（002）の平面間隔が3.54 Å以上であり、回折角度（2θ）が25.1度以下であり、2θバンドの半値幅が3.2度以上である請求項1又は2に記載のG H z帯域電子部品用樹脂組成物。

【請求項4】

樹脂が、ポリフェニレンエーテル系樹脂、シンジオタクチックポリスチレン樹脂、5-メチルペンテン樹脂、環状ポリオレフィン樹脂、耐熱性ABS樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、芳香族ポリサルホン樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリエーテルケトン系樹脂、ポリエーテルニトリル樹脂、サーモトロピック液晶ポリエステル樹脂、熱溶融性フッ素樹脂及び熱可塑性ポリイミド樹脂からなる群から選ばれた少なくとも1種の熱可塑性樹脂である請求項1に記載のG H z帯域電子部品用樹脂組成物。

【請求項5】

樹脂が、トリアジン系樹脂、熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂、エポキシ系樹脂及び不飽和ポリエステル樹脂からなる群から選ばれた少なくとも1種の熱硬化性樹脂である請求項1に記載のG H z帯域電子部品用樹脂組成物。

【請求項6】

樹脂が、熱硬化性樹脂の硬化物を分散した熱可塑性樹脂又は熱可塑性樹脂を分散した熱硬化性樹脂である請求項1に記載のG H z帯域電子部品用樹脂組成物。

【請求項7】

請求項1～6のいずれかに記載のG H z帯域電子部品用樹脂組成物から得られるG H z帯域電子部品。

【請求項8】

回路基板、半導体層間絶縁膜、アンテナ部品である請求項7に記載のG H z帯域電子部品。

【請求項9】

樹脂が本来有しているtan δがG H z帯域で0.1以下に低減されており、且つ、樹脂が本来有している他の物性が保持されている請求項7又は8に記載のG H z帯域電子部品。

【請求項10】

樹脂に対して0.001～0.4重量%の割合でナノスケールカーボンチューブを樹脂に配合することを特徴とする、当該樹脂から得られる電子部品のG H z帯域でのtan δを低減ないしG H z帯域でのtan δの上昇を抑制する方法。

【請求項 11】

樹脂に対して0.001～0.4重量%の割合でナノスケールカーボンチューブを樹脂に配合することを特徴とする、当該樹脂から得られる電子部品のGHz帯域での $\tan\delta$ を樹脂単独の場合に比し低減ないし上昇を抑制し、樹脂が本来有している他の物性（例えば、誘電特性、熱的特性、化学的特性、機械的特性等、特に誘電特性）を維持する方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】G H z 帯域電子部品用樹脂組成物及びG H z 帯域電子部品

【技術分野】

【0001】

本発明は、G H z 帯域電子部品用樹脂組成物に関する。更に詳しくは、本発明は、低誘電正接を具備し、電気・電子機器の回路基板材料、特にG H z 帯域用の回路基板材料、その他の電子部品の製造用に好適な樹脂組成物に関する。また、本発明はかかる樹脂組成物から得られる電子部品にも関する。

【背景技術】

【0002】

近年、通信情報量の急増に伴い、P H S、携帯電話等の情報通信機器の小型化、軽量化、高速化が強く望まれており、これに対応できる低誘電性電気絶縁材料が要求されている。特に自動車電話、デジタル携帯電話等の携帯移動体通信、衛星通信などのモバイル通信機器等に使用される電波の周波数帯域はメガからギガH z 帯の高周波帯域のものが使用されている。また、使用可能波長帯域が減少していることにより、マイクロ波・ミリ波帯といった高周波帯域の利用が進んできている。また、コンピュータのC P UクロックタイムはG H z 帯に達し、高周波数化が進行している。このような高周波帯域に対応した通信機の小型化、軽量化のためには、優れた高周波伝送特性と低誘電性特性とをあわせ持つ電気絶縁材料の開発が必要である。

【0003】

電子機器の回路基板材料には、多くの場合、比誘電率や誘電正接等の誘電特性が低く、耐熱性や機械的強度等の物理的特性に優れることが要求される。比誘電率 (ϵ) とは、誘電体内的分極の程度を示すパラメーターであり、比誘電率が高い程電気信号の伝播遅延が大きくなる。従って、信号の伝播速度を高め、高速演算を可能にするためには、比誘電率は低い方が好ましい。誘電正接 ($\tan \delta$) は、誘電体内に伝播する信号が熱に変換されて失われる量を示すパラメーターであり、誘電正接が低い程信号の損失が少なくなり、信号伝達率が向上する。

【0004】

即ち、素子回路内では誘電損失といわれる伝送過程におけるエネルギー損失が生じ、このエネルギー損失は熱エネルギーとして素子回路内に放出されるため好ましくない。このエネルギー損失は、低周波帯域においては、誘電分極によって生じた双極子の電界変化により振動するために生ずるものであり、高周波帯域においては、イオン分極や電子分極によって生ずるものである。交番電界 1 サイクル当たり誘電体中で消費されるエネルギーと誘電体中に蓄えられるエネルギーの比を誘電正接といい、 $\tan \delta$ で表される。

【0005】

$\tan \delta$ は高周波帯域では周波数の増加にともなって増大し、また電子素子の高密度実装化により単位面積当たりの発熱量が多くなるので、絶縁材料の誘電損失を少しでも小さくするためには、 $\tan \delta$ の小さな材料を用いる必要がある。誘電損失の小さい低誘電性高分子材料を用いることにより、誘電損失および電気抵抗による発熱が抑制され、その結果、信号の誤作動も少なくなることから、高周波通信分野においては伝送損失（エネルギーロス）の少ない材料が強く望まれている。

【0006】

このように、これまででは、プリント配線板における高速伝搬、高特性インピーダンス、配線板の薄型化、クロストークの減少などを目的として低比誘電率配線板の開発を行ってききたが、その一方で、高周波、マイクロウェーブ回路その他配線板における遅延回路の形成、低インピーダンス回路における配線板の特性インピーダンスの整合、配線パターンの細密化、基板自身にコンデンサー効果を持たせた素子の複合回路化等の要求から高比誘電率基板が必要とされる場合もある。

【0007】

電気絶縁性であり、低誘電率である等の電気特性を有する材料として、通常、ポリオレ

フイン、塩化ビニル樹脂、フッ素系樹脂等の熱可塑性樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、ビスマレイミドトリアジン樹脂（BTレジン）、架橋性ポリフェニレンオキサイド、硬化性ポリフェニレンエーテル等の熱硬化性樹脂などが、次の特性を満足させるため種々開発されている。

[0 0 0 8]

- ・積層板のドリル加工性、切削加工性
 - ・高耐熱性
 - ・低線膨張率
 - ・金属導体層との密着性ないし接着性（銅箔密着性）
 - ・機械的強度
 - ・薄膜形成能
 - ・比誘電率を比較的広範囲に渡って任意に設定することが可能
 - ・絶縁性
 - ・耐候性
 - ・誘電特性が温度、湿度に対して依存性が少ない。

[0009]

しかしながら、上記樹脂には下記のような問題点がある。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(1) ポリオレフィン

(1) ポリオレフィン
ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィンは、C—C結合等の共有結合を有し、且つ大きな極性基を持たないため、電気特性、特に絶縁抵抗性に優れているが、耐熱性が低いという欠点がある。このため高温下での使用における電気特性（誘電損失、比誘電率など）が悪化して、コンデンサー等の絶縁膜（層）として好適とはいえない。

[0 0 1 1]

ポリエチレンやポリプロピレンは、一旦フィルムとして形成させ、これを接着剤を用いて導電材料に被覆接着しているが、この方法は加工工程が複雑となるばかりでなくフィルム形成層の厚みを薄くすることが非常に難しいなど、被覆形成上の問題もある。

[0 0 1 2]

(2) 塩化ビニル樹脂

塩化ビニル樹脂は、絶縁抵抗性が高く、耐薬品性、難燃性に優れているが、ポリオレフィンと同様耐熱性に欠け、誘電損失が大きいという欠点がある。

[0013]

(3) フッ化ビニリデン樹脂、トリフルオロエチレン樹脂、およびパーフルオロエチレン樹脂

樹脂
フッ素原子を分子鎖中に含有しているこれら重合体は、電気特性（低誘電率、低誘電損失）、耐熱性、化学安定性に優れているが、熱可塑性樹脂のように熱処理加工することによって成形物、あるいはフィルム等を得るというような成形加工性、塗膜形成能に難があり、且つデバイス化を行う際、かなりのコスト高となる。さらに透明性が低いため応用分野が限られているという欠点がある。

[0 0 1 4]

(4) エポキシ樹脂

(4) エポキシ樹脂
エポキシ樹脂は、絶縁抵抗性、絶縁破壊強度と耐熱温度においては要求性能を満たしている。しかし、比誘電率が3以上と比較的高く、満足される特性が得られていない。そして薄膜形成能に乏しいといった欠点もある。ポリフェニレンオキサイド樹脂(PPO)と多官能シアン酸エステル樹脂類、さらにこれら樹脂に他の樹脂を配合し、ラジカル重合開始剤を添加し、予備反応させてなる硬化可能な変性PPO樹脂組成物が知られているが、低比誘電率化は充分満足できるレベルまで至っていない。さらに耐熱性の乏しいエポキシ樹脂の改良目的で、例えばフェノールノボラック樹脂、ビニルトリアジン樹脂等の組合せも検討されているが、フィルムとして力学的特性が著しく低下するという欠点がある。そこで、電気特性を維持したまま上記の問題点、具体的には加熱加工性の改良、銅などの金

属導電体（層）との密着性や接着性の改良を目的として、分岐シクロ環アモルファスフッ素ポリマー、パーフルオロエチレンモノマーと他のモノマーとの共重合体等が提案されているが、比誘電率、誘電損失等の電気特性は満たすものの、高分子主鎖に存在するメチレン鎖の影響のため耐熱性が悪化し、デバイス基板等に対する密着性が良好なものはまだ得られていない。

【0015】

(5) ポリイミド、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンスルフィド、ポリスルfonyl、熱硬化性ポリフェニレンエーテル (PPE)、ポリエチレンテレフタレート
誘電性・絶縁抵抗性に優れた低誘電率材料にさらに求められる性能として、デバイス化工程のなかに必ず半田付け工程が入るため少なくとも 260°C で 120 秒の加熱に耐え得るだけの耐熱性が要求され、耐熱性、耐アルカリ性等の化学的安定性、および耐湿性や機械的特性に優れたものでなければならない。これらの要求を満足する高分子素材として、例えばポリイミド、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンスルフィド、ポリスルfonyl、熱硬化性ポリフェニレンエーテル (PPE)、ポリエチレンテレフタレート等が知られている。しかし、これら樹脂であっても、誘電損失が GHz 帯域では大きくなってくる。

【0016】

このように前述した特性を達成するには樹脂単独では種々の難点があるため、樹脂に添加剤を添加して、樹脂の電気的性質を改善することが提案されている。例えば、特許文献 1 では、合成樹脂に特定のケイ酸金属塩系纖維状物を特定量配合すると、高周波域での使用に支障をきたす程の比誘電率及び誘電正接の上昇を伴うことなく、熱伝導性、耐熱性及び機械的強度をも向上させることができ、加えて、配合する樹脂の種類によっては、比誘電率を同程度に維持したまま、誘電正接を著しく低下させ得るので、従来、合成樹脂が適用してきた電気・電子部品とは異なった電気的用途である回路基板材料、特に高周波用の回路基板材料として極めて好適に使用できることを提案している。

【0017】

より具体的には、特許文献 1 では、熱可塑性樹脂（ポリアミド樹脂を除く）及び／又は熱硬化性樹脂（フェノール樹脂を除く）に、一般式 $aM_xO_y \cdot bSiO_2 \cdot cH_2O$ (ここで a 、 b 及び c は正の実数を示す。 x が 1 の場合は y は 1 を、 x が 2 の場合は y は 1 又は 3 をそれぞれ示す。M は Mg、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Al、Ga、Sr、Y、Zr、Nb、Mo、Pb、Ba、W 及び Li なる群より選ばれた少なくとも 1 種以上の金属元素を示す。) で表されるケイ酸金属塩系纖維状物質を主成分とする強化纖維を、上記樹脂及び上記纖維状物質の合計重量を基準として 5～60 重量% の割合で配合してなることを特徴とする高周波電子部品用樹脂組成物を提案している。

【0018】

しかし、上記特許文献 1 では、熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂に対する強化纖維の配合割合が少なくとも約 5 重量% 以上であり、該強化纖維を大量に使用する必要がある。

【特許文献 1】特開平 8-134263 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0019】

本発明は、樹脂に少量添加するだけで、GHz 帯域における誘電損失 ($\tan \delta$) を低減させることができる添加剤を開発し、種々の要請に柔軟に応えることができる電子部品用樹脂組成物を提供することを主たる目的とする。

【0020】

また、本発明の他の目的は、低比誘電率、低誘電正接、高耐熱性、高機械的強度を具備する電気・電子機器の回路基板材料、特に GHz 帯域用の回路基板材料、その他の電子部品の製造用に極めて好適な樹脂組成物を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0021】

本発明者らは、上記目的達成のため銳意検討した結果、合成樹脂に特定のナノスケール

カーボンチューブを特定範囲の少量で配合する場合には、高周波帯域、特にG H z 帯域で誘電正接の上昇を抑えることを見出した。また、熱伝導性、耐熱性、機械的強度、比誘電率などの合成樹脂の有する特性が維持されるので、従来、合成樹脂が適用されてきた電気・電子部品とは異なった電気的用途である回路基板材料、特にG H z 帯域用の回路基板材料として極めて好適に使用できることを見出した。

【0022】

ナノスケールカーボンチューブは本来導電性を有しているので、前記特許文献1のように5重量%以上も添加すると、得られる樹脂組成物から形成される電子部品も導電性を有する。よって、高周波帯域の電子部品用の樹脂組成物に、特許文献1に記載のようにナノスケールカーボンチューブを大量に配合することは考えられず、従来、ナノスケールカーボンチューブで高周波帯域の誘電正接を低減させることは従来試みられたことはなかった。ところが、本発明者の研究によると、ナノスケールカーボンチューブを、上記特許文献1に記載の5重量%を遙かに下回る微量配合することにより、G H z 帯域において、誘電正接が低下するか、又は、誘電正接の上昇を抑制できるという全く予想外の結果が得られたのである。

【0023】

本発明は斯かる知見に基づき、更に検討を重ねて完成されたものであって、次の電子部品用樹脂組成物、電子部品等を提供するものである。

【0024】

項1 熱可塑性樹脂及び熱硬化性樹脂から選ばれた少なくとも1種の樹脂及びナノスケールカーボンチューブを含有し、ナノスケールカーボンチューブが上記樹脂を基準として0.001～0.4重量%の割合で含有されていることを特徴とするG H z 帯域電子部品用樹脂組成物。

【0025】

項2 ナノスケールカーボンチューブが、

- (i) 単層カーボンナノチューブ又は入れ子構造の多層カーボンナノチューブ、
- (ii) アモルファスナノスケールカーボンチューブ、
- (iii) ナノフレークカーボンチューブ、
- (iv) (a)ナノフレークカーボンチューブ及び入れ子構造の多層カーボンナノチューブからなるカーボンチューブと、(b)炭化鉄又は鉄とからなり、該カーボンチューブ(a)のチユーブ内空間部の10～90%の範囲に、該炭化鉄又は鉄(b)が存在している鉄一炭素複合体、又は
- (v) 上記(i)～(iv)の2種以上の混合物

であることを特徴とする項1に記載のG H z 帯域電子部品用樹脂組成物。

【0026】

項3 ナノスケールカーボンチューブが、アモルファスナノスケールカーボンチューブであって、X線回折法（入射X線：C u K α ）において、ディフラクトメーター法により測定される炭素網平面（002）の平面間隔が3.54 Å以上であり、回折角度（2θ）が25.1度以下であり、2θバンドの半値幅が3.2度以上である項1又は2に記載のG H z 帯域電子部品用樹脂組成物。

【0027】

項4 樹脂が、ポリフェニレンエーテル系樹脂、シンジオタクチックポリスチレン樹脂、5-メチルペンテン樹脂、環状ポリオレフィン樹脂、耐熱性A B S樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、芳香族ポリサルホン樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリエーテルケトン系樹脂、ポリエーテルニトリル樹脂、サーモトロピック液晶ポリエステル樹脂、熱可塑性フッ素樹脂及び熱可塑性ポリイミド樹脂からなる群から選ばれた少なくとも1種の熱可塑性樹脂である項1に記載のG H z 帯域電子部品用樹脂組成物。

【0028】

項5 樹脂が、トリアジン系樹脂、熱硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂、エポキシ系樹脂及び不飽和ポリエステル樹脂からなる群から選ばれた少なくとも1種の熱硬化性樹脂

である項1に記載のG H z帯域電子部品用樹脂組成物。

【0029】

項6 樹脂が、熱硬化性樹脂の硬化物を分散した熱可塑性樹脂又は熱可塑性樹脂を分散した熱硬化性樹脂である項1に記載のG H z帯域電子部品用樹脂組成物。

【0030】

項7 項1～6のいずれかに記載のG H z帯域電子部品用樹脂組成物から得られるG H z帯域電子部品。

【0031】

項8 回路基板、半導体層間絶縁膜、アンテナ部品である項7に記載のG H z帯域電子部品。

【0032】

項9 樹脂が本来有しているtan δ がG H z帯域で0.1以下に低減されており、且つ、樹脂が本来有している他の物性が保持されている項7又は8に記載のG H z帯域電子部品。

【0033】

項10 樹脂に対して0.001～0.4重量%の割合でナノスケールカーボンチューブを樹脂に配合することを特徴とする、当該樹脂から得られる電子部品のG H z帯域でのtan δ を低減ないしG H z帯域でのtan δ の上昇を抑制する方法。

【0034】

項11 樹脂に対して0.001～0.4重量%の割合でナノスケールカーボンチューブを樹脂に配合することを特徴とする、当該樹脂から得られる電子部品のG H z帯域でのtan δ を樹脂単独の場合に比し低減ないし上昇を抑制し、樹脂が本来有している他の物性、例えば、誘電特性、熱的特性、化学的特性、機械的特性等（特に誘電特性）を維持する方法。

【発明の効果】

【0035】

本発明によれば、上記ナノスケールカーボンチューブを樹脂に0.001～0.4重量%という極めて少量添加してなる樹脂組成物から得られる電子部品は、G H z帯域において、誘電正接（tan δ ）が樹脂単独の場合よりも低下するか、または、樹脂単独の場合のtan δ の上昇を抑制することができ、一方、樹脂が本来有する比誘電率、耐熱性、機械的強度等の物性は実質上変化することなくそのまま維持される。

【0036】

従って、本発明に従って、低誘電率、高耐熱性、高機械的強度等の物性を有する樹脂にナノスケールカーボンチューブを少量配合してなる樹脂組成物から得られる電子部品は、G H z帯域において、樹脂単独に比し、誘電正接が低下するか又はその上昇が抑制されと共に、当該樹脂が本来持っている低誘電率、高耐熱性、高機械的強度等の物性が維持される。

【0037】

一方、高い比誘電率を有する樹脂を使用すると、G H z帯域において、誘電正接（tan δ ）が樹脂単独の場合よりも低下するか、または、樹脂単独の場合のtan δ の上昇を抑制することができ、一方、樹脂が本来有する比誘電率は高いまま保持され、また他の物性、例えば、耐熱性、機械的強度等の物性は実質上変化することなくそのまま維持される。

【0038】

従って、かかる樹脂組成物を使用することにより、電気・電子機器の回路基板材料、特にG H z帯域用の回路基板材料等として好適に使用できる電子部品が提供される。

【0039】

また、本発明では、ナノスケールカーボンチューブの添加により、樹脂の各種特性（誘電特性、熱的特性、化学的特性、機械的特性）を劣化させることなくG H z帯域で誘電正接の増大を抑えるので、樹脂の選択の幅が増大するという利点もある。

【発明を実施するための最良の形態】

【0040】ナノスケールカーボンチューブ

本発明で使用するナノスケールカーボンチューブとしては、ナノサイズの直径を有するカーボンチューブを指し、該カーボンチューブのチューブ内空間部には鉄等が内包されていてもよい。

【0041】

かかるナノスケールカーボンチューブとしては、(i)单層カーボンナノチューブ又は多層カーボンナノチューブ、(ii)本出願人が開発したアモルファスナノスケールカーボンチューブ、(iii)ナノフレークカーボンチューブ、(iv)(a)ナノフレークカーボンチューブ及び入れ子構造の多層カーボンナノチューブからなる群から選ばれるカーボンチューブと(b)炭化鉄又は鉄とからなり、該カーボンチューブ(a)のチューブ内空間部の10～90%の)炭化鉄又は鉄が充填されている鉄一炭素複合体、(v)これらの2種以上の混合物等を例示することができる。

【0042】

これらのうちでも、特に、上記アモルファスナノスケールカーボンチューブ、ナノフレークカーボンチューブおよび上記鉄一炭素複合体が、溶媒、バインダー中での分散が良好であり、好ましい。これらチューブが溶媒、バインダー中での分散が良好である理由は完全には解明されていないが、これらチューブの最外層の炭素網面が不連続であるため、溶媒、バインダー等との親和性が高くなっているためと推察される。

【0043】<カーボンナノチューブ>

カーボンナノチューブは、黒鉛シート（即ち、黒鉛構造の炭素原子面ないしグラフェンシート）がチューブ状に閉じた中空炭素物質であり、その直径はナノメートルスケールであり、壁構造は黒鉛構造を有している。カーボンナノチューブのうち、壁構造が一枚の黒鉛シートでチューブ状に閉じたものは单層カーボンナノチューブと呼ばれ、複数枚の黒鉛シートがそれぞれチューブ状に閉じて、入れ子状になっているものは入れ子構造の多層カーボンナノチューブと呼ばれている。本発明では、これら单層カーボンナノチューブ及び多層カーボンナノチューブがいずれも使用できる。

【0044】

本発明で使用できる单層カーボンナノチューブとしては、直径が0.4～10nm程度、長さが1～500μm程度のものが好ましく、直径が0.7～5nm程度、長さが1～100μm程度のものがさらに好ましく、特に、直径が0.7～2nm程度、長さが1～20μm程度のものが好ましい。

【0045】

また、本発明で使用できる多層カーボンナノチューブとしては、直径が1～100nm程度、長さが1～500μm程度のものが好ましく、直径が1～50nm程度、長さが1～100μm程度のものがさらに好ましく、特に、直径が1～40nm程度、長さが1～20μm程度のものが好ましい。

【0046】<アモルファスナノスケールカーボンチューブ>

また、上記アモルファスナノスケールカーボンチューブは、WO00/40509（特許第3355442号）に記載されており、カーボンからなる主骨格を有し、直径が0.1～1000nmであり、アモルファス構造を有するナノスケールカーボンチューブであって、直線状の形態を有し、X線回折法（入射X線：Cu K α ）において、ディフラクトメーター法により測定される炭素網平面（002）の平面間隔（d002）が3.54Å以上、特に3.7Å以上であり、回折角度（2θ）が25.1度以下、特に24.1度以下であり、2θ3.7Å以上であることを特徴とするものである。

【0047】

該アモルファスナノスケールカーボンチューブは、マグネシウム、鉄、コバルト、ニッケル等の金属の塩化物の少なくとも1種からなる触媒の存在下で、分解温度が200～9

00°Cである熱分解性樹脂、例えば、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ塩化ビニリデン、ポリフッ化ビニリデン、ポリビニルアルコール等を、励起処理することにより得られる。

【0048】

出発原料としての熱分解性樹脂の形状は、フィルム状乃至シート状、粉末状、塊状などの任意の形状であって良い。例えば、基板上に薄膜化アモルファスナノスケールカーボンチューブを形成させた炭素材料を得る場合には、基板上に熱分解性樹脂を塗布あるいは載置した状態で、適切な条件下に励起処理すればよい。

【0049】

該励起処理としては、例えば、不活性雰囲気中、好ましくは450~1800°C程度の温度域でかつ原料の熱分解温度以上で加熱する、室温~3000°C程度の温度域でかつ原料の熱分解温度以上でのプラズマ処理する等の処理が例示できる。

【0050】

本発明で使用するアモルファスナノスケールカーボンチューブは、アモルファス構造（非晶質構造）を有するナノスケールのカーボンナノチューブで、中空直線状であり、細孔が高度に制御されている。その形状は、主に円柱、四角柱などであり、先端の少なくとも一方が、キャップを有していない（開口している）場合が多い。先端が閉口している場合には、形状がフラット状である場合が多い。

【0051】

該アモルファスナノスケールカーボンチューブの外径は、通常1~1000nm程度の範囲にあり、好ましくは1~200nm程度の範囲にあり、より好ましくは、1~100nm程度の範囲にある。そのアスペクト比（チューブの長さ／直径）は2倍以上であり、好ましくは5倍以上である。

【0052】

ここで、「アモルファス構造」とは、規則的に配列した炭素原子の連続的な炭素層からなる黒鉛質構造ではなく、不規則な炭素網平面からなる炭素質構造を意味し、多数の微細なグラフェンシートが不規則に配列している。代表的な分析手法である透過型電子顕微鏡による像からは、本発明による非晶質構造のナノスケールカーボンチューブは、炭素網平面の平面方向の広がりがアモルファスナノスケールカーボンチューブの直径の1倍より小さい。このように、アモルファスナノスケールカーボンチューブは、その壁部が黒鉛構造ではなく多数の微細なグラフェンシート（炭素網面）が不規則に分布したアモルファス構造を有しているため、最外層を構成する炭素網面は、チューブ長手方向の全長にわたって連續しておらず、不連続となっている。特に、最外層を構成する炭素網面の長さは、20nm未満、特に5nm未満である。

【0053】

非晶質炭素は一般的にはX線回折を示さないが、プロードな反射を示す。黒鉛質構造では、炭素網平面が規則的に積み重なっているので、炭素網平面間隔(d_{002})が狭くなり、プロードな反射は高角側(2θ)に移行して、次第に鋭くなり(2θ バンドの半値幅が狭くなり)、 d_{002} 回折線として観測できるようになる（黒鉛的位置関係で規則正しく積み重なっている場合は $d_{002}=3.354\text{ \AA}$ である）。

【0054】

これに対し、非晶質構造は、上記のように一般的にはX線による回折を示さないが、部分的に非常に弱い干渉性散乱を示す。X線回折法(入射X線=CuK α)において、ディフラクтомーター法により測定される本発明によるアモルファスナノスケールカーボンチューブの理論的な結晶学的特性は、以下の様に規定される：炭素網平面間隔(d_{002})は、3.54 \AA 以上であり、より好ましくは3.7 \AA 以上である；回折角度(2θ)は、25.1度以下であり、より好ましくは24.1度以下である；前記 2θ バンドの半値幅は、3.2度以上であり、より好ましくは7.0度以上である。

【0055】

典型的には、本発明で使用するアモルファスナノスケールカーボンチューブは、X線回

折による回折角度(2θ)が18.9~22.6度の範囲内にあり、炭素網平面間隔(d_{002})は3.9~4.7Åの範囲内にあり、 2θ バンドの半値幅は7.6~8.2度の範囲内にある。

【0056】

本発明のアモルファスナノスケールカーボンチューブの形状を表す一つの用語である「直線状」なる語句は、次のように定義される。すなわち、透過型電子顕微鏡によるアモルファスナノスケールカーボンチューブ像の長さをLとし、そのアモルファスナノスケールカーボンチューブを伸ばした時の長さをL₀とした場合に、 L/L_0 が0.9以上となる形状特性を意味するものとする。

【0057】

かかるアモルファスナノスケールカーボンチューブのチューブ壁部分は、あらゆる方向に配向した複数の微細な炭素網平面(グラフェンシート)からなる非晶質構造であり、これらの炭素網平面の炭素平面間隔により活性点を有するためか、樹脂との親和性に優れているという利点を有する。

【0058】

<鉄-炭素複合体>

また、本発明で使用する上記鉄-炭素複合体は、特開2002-338220号公報に記載されており、(a)ナノフレークカーボンチューブ及び入れ子構造の多層カーボンナノチューブからなる群から選ばれるカーボンチューブと(b)炭化鉄又は鉄とからなり、該カーボンチューブ(a)のチューブ内空間部の10~90%の範囲に(b)の炭化鉄又は鉄が充填されている。即ち、チューブ内空間部の100%の範囲に完全に充填されているものではなく、上記炭化鉄又は鉄がそのチューブ内空間部の10~90%の範囲に充填されている(即ち、部分的に充填されている)ことを特徴とするものである。壁部は、パッチワーク状ないし張り子状(いわゆるpaper mache状)のナノフレークカーボンチューブである。

【0059】

本願特許請求の範囲及び明細書において、「ナノフレークカーボンチューブ」とは、フレーク状の黒鉛シートが複数枚(通常は多数)パッチワーク状ないし張り子状(paper mache状)に集合して構成されている、黒鉛シートの集合体からなる炭素製チューブを指す。

【0060】

かかる鉄-炭素複合体は、特開2002-338220号公報に記載の方法に従って、(1)不活性ガス雰囲気中、圧力を 10^{-5} Pa~200kPaに調整し、反応炉内の酸素濃度を、反応炉容積をA(リットル)とし酸素量をB(Ncc)とした場合の比B/Aが $1 \times 10^{-10} \sim 1 \times 10^{-1}$ となる濃度に調整した反応炉内でハロゲン化鉄を600~900℃まで加熱する工程、及び(2)上記反応炉内に不活性ガスを導入し、圧力 10^{-5} Pa~200kPaで熱分解性炭素源を導入して600~900℃で加熱処理を行う工程を含む製造方法により製造される。

【0061】

ここで、酸素量Bの単位である「Ncc」は、気体の25℃での標準状態に換算したときの体積(cc)という意味である。

【0062】

該鉄-炭素複合体は、(a)ナノフレークカーボンチューブ及び入れ子構造の多層カーボンナノチューブからなる群から選ばれるカーボンチューブと(b)炭化鉄又は鉄とからなるものであって、該カーボンチューブ内空間部(即ち、チューブ壁で囲まれた空間)の実質上全てが充填されているのではなく、該空間部の一部、より具体的には10~90%程度、特に30~80%程度、好ましくは40~70%程度が炭化鉄又は鉄により充填されている。

【0063】

本発明で使用する鉄-炭素複合体においては、特開2002-338220号公報に記載されているように、炭素部分は、製造工程(1)及び(2)を行った後、特定の速度で冷却す

るとナノフレークカーボンチューブとなり、製造工程(1)及び(2)を行った後、不活性気体中で加熱処理を行い、特定の冷却速度で冷却することにより、入れ子構造の多層カーボンナノチューブとなる。

【0064】

<(a-1)ナノフレークカーボンチューブ>

本発明のナノフレークカーボンチューブと炭化鉄又は鉄からなる鉄一炭素複合体は、典型的には円柱状であるが、そのような円柱状の鉄一炭素複合体（特開2002-338220号公の実施例1で得られたもの）の長手方向を横切る断面の透過型電子顕微鏡(TEM)写真を図3に示し、側面のTEM写真を図1に示す。

【0065】

また、図4の(a-1)にそのような円柱状のナノフレークカーボンチューブのTEM像の模式図を示す。図4の(a-1)において、100は、ナノフレークカーボンチューブの長手方向のTEM像を模式的に示しており、200は、ナノフレークカーボンチューブの長手方向にほぼ垂直な断面のTEM像を模式的に示している。

【0066】

本発明で使用する鉄一炭素複合体を構成するナノフレークカーボンチューブは、代表的には、中空円筒状の形態を有し、その断面をTEM観察した場合、弧状グラフェンシート像が同心円状に集合しており、個々のグラフェンシート像は、不連続な環を形成しており、その長手方向をTEMで観察した場合、略直線状のグラフェンシート像が、長手方向にほぼ並行に多層状に配列しており、個々のグラフェンシート像は、長手方向全長にわたって連続しておらず、不連続となっているという特徴を有している。

【0067】

より詳しくは、本発明で使用する鉄一炭素複合体を構成しているナノフレークカーボンチューブは、図3及び図4の(a-1)の200から明らかのように、その長手方向に垂直な断面をTEM観察した場合、多数の弧状グラフェンシート像が同心円状（多層構造のチューブ状）に集合しているが、個々のグラフェンシート像は、例えば210、214に示すように、完全に閉じた連続的な環を形成しておらず、途中で途切れた不連続な環を形成している。一部のグラフェンシート像は、211に示すように、分岐している場合もある。不連続点においては、一つの不連続環を構成する複数の弧状TEM像は、図4の(a-1)の222に示すように、層構造が部分的に乱れている場合もあれば、223に示すように隣接する層構造が部分的に重なり合っている場合もあるが、TEMで観察される多数のグラフェンシート像との間に間隔が存在している場合もあるが、TEMで観察される多数の弧状グラフェンシート像は、全体として、多層状のチューブ構造を形成している。

【0068】

また、図1及び図4の(a-1)の100から明らかのように、ナノフレークカーボンチューブの長手方向をTEMで観察した場合、多数の略直線状のグラフェンシート像が本発明で使用する鉄一炭素複合体の長手方向にほぼ並行に多層状に配列しているが、個々のグラフェンシート像110は、鉄一炭素複合体の長手方向全長にわたって連続しておらず、途中で不連続となっている。一部のグラフェンシート像は、図4の(a-1)の111に示すように、分岐している場合もある。また、不連続点においては、層状に配列したTEM像のうち、一つの不連続層のTEM像は、図4の(a-1)の112に示すように、隣接するグラフェンシート像と少なくとも部分的に重なり合っている場合もあれば、113に示すように隣接するグラフェンシート像と少し離れている場合もあるが、多数の略直線状のTEM像が、全体として多層構造を形成している。

【0069】

かかる本発明のナノフレークカーボンチューブの構造は、従来の多層カーボンナノチューブと大きく異なっている。即ち、図4の(a-2)の400に示すように、入れ子構造の多層カーボンナノチューブは、その長手方向に垂直な断面のTEM像が、410に示すように、実質上完全な円形のTEM像となっている同心円状のチューブであり、且つ、図4の(a-2)の300に示すように、その長手方向の全長にわたって連続する直線状グラフェンシート像310等が平行に配列している構造（同心円筒状ないし入れ子状の構造）である。

【0070】

以上より、詳細は未だ完全には解明されていないが、本発明で使用する鉄一炭素複合体を構成するナノフレークカーボンチューブは、フレーク状のグラフェンシートが多数パックチワーク状ないし張り子状に重なり合って全体としてチューブを形成しているようにみえる。

【0071】

このような本発明のナノフレークカーボンチューブとそのチューブ内空間部に内包された炭化鉄又は鉄からなる鉄一炭素複合体は、特許第2546114号に記載されているような入れ子構造の多層カーボンナノチューブのチューブ内空間部に金属が内包された複合体に比し、カーボンチューブの構造において大きく異なっている。

【0072】

本発明で使用する鉄一炭素複合体を構成しているナノフレークカーボンチューブをTEM観察した場合において、その長手方向に配向している多数の略直線状のグラフェンシート像に関し、個々のグラフェンシート像の長さは、通常、2～500nm程度、特に10～100nm程度である。即ち、図4の(a-1)の100に示されるように、110で示される略直線状のグラフェンシートのTEM像が多数集まってナノフレークカーボンチューブの壁部のTEM像を構成しており、個々の略直線状のグラフェンシート像の長さは、通常、2～500nm程度、特に10～100nm程度である。

【0073】

このように、鉄一炭素複合体においては、その壁部を構成するナノフレークカーボンチューブの最外層は、チューブ長手方向の全長にわたって連続していない不連続なグラフェンシートから形成されており、その最外面の炭素網面の長さは、通常、2～500nm程度、特に10～100nm程度である。

【0074】

本発明で使用する鉄一炭素複合体を構成するナノフレークカーボンチューブの壁部の炭素部分は、上記のようにフレーク状のグラフェンシートが多数長手方向に配向して全体としてチューブ状となっているが、X線回折法により測定した場合に、炭素網面間の平均距離(d_{002})が0.34nm以下の黒鉛質構造を有するものである。

【0075】

また、本発明で使用する鉄一炭素複合体のナノフレークカーボンチューブからなる壁部の厚さは、49nm以下、特に0.1～20nm程度、好ましくは1～10nm程度であって、全長に亘って実質的に均一である。

【0076】*<(a-2)入れ子構造の多層カーボンナノチューブ>*

前記のように、工程(1)及び(2)を行った後、特定の加熱工程を行うことにより、得られる鉄一炭素複合体を構成するカーボンチューブは、入れ子構造の多層カーボンナノチューブとなる。

【0077】

こうして得られる入れ子構造の多層カーボンナノチューブは、図4の(a-2)の400に示すように、その長手方向に垂直な断面のTEM像が実質的に完全な円を構成する同心円状のチューブであり、且つ、その長手方向の全長にわたって連続したグラフェンシート像が平行に配列している構造(同心円筒状ないし入れ子状の構造)である。

【0078】

本発明で使用する鉄一炭素複合体を構成する入れ子構造の多層カーボンナノチューブの壁部の炭素部分は、X線回折法により測定した場合に、炭素網面間の平均距離(d_{002})が0.34nm以下の黒鉛質構造を有するものである。

【0079】

また、本発明で使用する鉄一炭素複合体の入れ子構造の多層カーボンナノチューブからなる壁部の厚さは、49nm以下、特に0.1～20nm程度、好ましくは1～10nm程度であって、全長に亘って実質的に均一である。

【0080】

<(b)内包されている炭化鉄又は鉄>

本明細書において、上記ナノフレークカーボンチューブ及び入れ子構造の多層カーボンナノチューブからなる群から選ばれるカーボンチューブ内空間部の炭化鉄又は鉄による充填率（10～90%）は、本発明で使用する鉄一炭素複合体を透過型電子顕微鏡で観察し、各カーボンチューブの空間部（即ち、カーボンチューブのチューブ壁で囲まれた空間）の像の面積に対する、炭化鉄又は鉄が充填されている部分の像の面積の割合である。

【0081】

炭化鉄又は鉄の充填形態は、カーボンチューブ内空間部に連続的に充填されている形態、カーボンチューブ内空間部に断続的に充填されている形態等があるが、基本的には断続的に充填されている。従って、本発明で使用する鉄一炭素複合体は、金属内包炭素複合体ないし鉄化合物内包炭素複合体、炭化鉄又は鉄内包炭素複合体とも言うべきものである。

【0082】

また、本発明で使用する鉄一炭素複合体に内包されている炭化鉄又は鉄は、カーボンチューブの長手方向に配向しており、結晶性が高く、炭化鉄又は鉄が充填されている範囲のTEM像の面積に対する、結晶性炭化鉄又は鉄のTEM像の面積の割合（以下「結晶化率」という）は、一般に、90～100%程度、特に95～100%程度である。

【0083】

内包されている炭化鉄又は鉄の結晶性が高いことは、本発明鉄一炭素複合体の側面からTEM観察した場合、内包物のTEM像が格子状に配列していることから明らかであり、電子線回折において明確な回折パターンが得られることからも明らかである。

【0084】

また、本発明で使用する鉄一炭素複合体に炭化鉄又は鉄が内包されていることは、電子顕微鏡、EDX（エネルギー分散型X線検出器）により容易に確認することができる。

【0085】

<鉄一炭素複合体の全体形状>

本発明で使用する鉄一炭素複合体は、湾曲が少なく、直線状であり、壁部の厚さが全長に亘ってほぼ一定の均一厚さを有しているので、全長に亘って均質な形状を有している。その形状は、柱状で、主に円柱状である。

【0086】

本発明による鉄一炭素複合体の外径は、通常、1～100nm程度、特に1～50nm程度の範囲にあり、好ましくは1～30nm程度の範囲にあり、より好ましくは10～30nm程度の範囲にある。チューブの長さ（L）の外径（D）に対するアスペクト比（L/D）は、5～10000程度であり、特に10～100程度である。

【0087】

本発明で使用する鉄一炭素複合体の形状を表す一つの用語である「直線状」なる語句は、次のように定義される。即ち、透過型電子顕微鏡により本発明で使用する鉄一炭素複合体を含む炭素質材料を200～2000nm四方の範囲で観察し、像の長さをWとし、該像を直線状に伸ばした時の長さをW₀とした場合に、比W/W₀が、0.8以上、特に、0.9以上となる形状特性を意味するものとする。

【0088】

本発明で使用する鉄一炭素複合体は、バルク材料としてみた場合、次の性質を有する。即ち、本発明では、上記のようなナノフレークカーボンチューブ及び入れ子構造の多層カーボンナノチューブから選ばれるカーボンチューブのチューブ内空間部の10～90%の範囲に鉄または炭化鉄が充填されている鉄一炭素複合体は、顕微鏡観察によりかろうじて観察できる程度の微量ではなく、多数の該鉄一炭素複合体を含むバルク材料であって、鉄一炭素複合体を含む炭素質材料、或いは、炭化鉄又は鉄内包炭素質材料ともいるべき材料の形態で大量に得られる。

【0089】

特開2002-338220号公報の実施例1で製造されたナノフレークカーボンチューブ

出証特2005-3020406

ーブとそのチューブ内空間に充填された炭化鉄からなる本発明炭素質材料の電子顕微鏡写真を、図2に示す。

【0090】

図2から判るように、本発明で使用する鉄一炭素複合体を含む炭素質材料においては、基本的にはほとんど全ての（特に99%又はそれ以上の）カーボンチューブにおいて、その空間部（即ち、カーボンチューブのチューブ壁で囲まれた空間）の10～90%の範囲に炭化鉄又は鉄が充填されており、空間部が充填されていないカーボンチューブは実質上存在しないのが通常である。但し、場合によっては、炭化鉄又は鉄が充填されていないカーボンチューブも微量混在することがある。

【0091】

また、本発明の炭素質材料においては、上記のようなカーボンチューブ内空間部の10～90%に鉄または炭化鉄が充填されている鉄一炭素複合体が主要構成成分であるが、本発明の鉄一炭素質複合体以外に、スズ等が含まれている場合がある。そのような場合は、本発明の鉄一炭素質複合体以外の成分を除去して、本発明の炭素質材料中の鉄一炭素質複合体の純度を向上させ、実質上本発明で使用する鉄一炭素複合体のみからなる炭素質材料を得ることもできる。

【0092】

また、従来の顕微鏡観察で微量確認し得るに過ぎなかった材料とは異なり、本発明で使用する鉄一炭素複合体を含む炭素質材料は大量に合成できるので、その重量を容易に1mg以上とすることができます。

【0093】

本発明炭素質材料は、該炭素質材料1mgに対して 25 mm^2 以上の照射面積で、Cu K α のX線を照射した粉末X線回折測定において、内包されている鉄または炭化鉄に帰属される $40^\circ < 2\theta < 50^\circ$ のピークの中で最も強い積分強度を示すピークの積分強度をIaとし、カーボンチューブの炭素網面間の平均距離(d002)に帰属される $26^\circ < 2\theta < 27^\circ$ のピークの積分強度Ibとした場合に、IaのIbに対する比R(=Ia/Ib)が、0.35～5程度、特に0.5～4程度であるのが好ましく、より好ましくは1～3程度である。

【0094】

本明細書において、上記Ia/Ibの比をR値と呼ぶ。このR値は、本発明で使用する鉄一炭素複合体を含む炭素質材料を、X線回折法において 25 mm^2 以上のX線照射面積で観察した場合に、炭素質材料全体の平均値としてピーク強度が観察されるために、TEM分析で測定できる1本の鉄一炭素複合体における内包率ないし充填率ではなく、鉄一炭素複合体の集合物である炭素質材料全体としての、炭化鉄又は鉄充填率ないし内包率の平均値を示すものである。

【0095】

尚、多数の本発明鉄一炭素複合体を含む炭素質材料全体としての平均充填率は、TEMで複数の視野を観察し、各視野で観察される複数の鉄一炭素複合体における炭化鉄又は鉄の平均充填率を測定し、更に複数の視野の平均充填率の平均値を算出することによっても求めることができる。かかる方法で測定した場合、本発明で使用する鉄一炭素複合体からなる炭素質材料全体としての炭化鉄又は鉄の平均充填率は、10～90%程度、特に40～70%程度である。

【0096】

<ナノフレークカーボンチューブ>

上記の鉄又は炭化鉄がナノフレークカーボンチューブのチューブ内空間に部分内包されている鉄一炭素複合体を酸処理することにより、内包されている鉄又は炭化鉄が溶解除去され、チューブ内空間部に鉄又は炭化鉄が存在しない中空のナノフレークカーボンチューブを得ることができる。

【0097】

上記酸処理に使用する酸としては、塩酸、硫酸、硝酸、フッ酸等を例示でき、その濃度

は0.1～2N程度のものが好ましい。酸処理方法としては、種々の方法により行うこと が可能であるが、例えば、1Nの塩酸100mlに対して、1gの鉄内包ナノフレークカーボンチューブを分散し、室温で6時間攪拌処理し、ろ過分離した後、さらに、2回1Nの塩酸100mlで同様の処理を行なうことで、中空のナノフレークカーボンチューブを得ることができる。

【0098】

この酸処理によってもナノフレークカーボンチューブの基本的構成は特に変化を受けない。よって、チューブ内空間部に鉄又は炭化鉄が存在しない中空のナノフレークカーボンチューブにおいても、その最外面を構成する炭素網面の長さは、500nm以下であり、特に2～500nm、特に10～100nmである。

【0099】

樹脂

本発明では、電子部品の分野で使用されている各種の熱可塑性樹脂及び熱硬化性樹脂からなる群から選ばれた少なくとも1種を使用する。

【0100】

本発明で使用される熱可塑性樹脂としては、広い範囲のものが使用できるが、例えば、ポリフェニレンエーテル系樹脂（特に、ポリフェニレンエーテル、若干のポリスチレンもしくはスチレン・ブタジエン系エラストマーを添加して耐衝撃性や成形性を改善したポリフェニレンエーテル樹脂等）、メタロセン触媒を使用して構造制御することにより得られるシンジオタクチックポリスチレン、5-メチルペンテン樹脂、ポリノルボルネン樹脂等の環状オレフィンを成分に含む環状ポリオレフィン樹脂、マレイミドを共重合することにより熱変形温度を高めた耐熱性ABS樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、芳香族ポリサルホン系樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリエーテルケトン系樹脂、ポリエーテルニトリル樹脂、サーモトロピック液晶ポリエステル樹脂、エチレン/テトラフルオロエチレンコポリマー、テトラフルオロエチレン/パーカルオロアルコキシビニルエーテルコポリマー等の熱溶融性フッ素樹脂、熱可塑性ポリイミド樹脂等を例示できる。本発明では、これら熱可塑性樹脂の中から1種を単独で使用してもよく、又は2種以上を併用してもよい。

【0101】

上記の樹脂は、光硬化性樹脂であってもよい。光硬化性樹脂としては、例えば、紫外線硬化性樹脂及び電子線硬化性樹脂のいずれであってもよい。紫外線硬化型樹脂又は電子線硬化型樹脂としては、公知の様々なものが使用でき、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、エヌステル樹脂等があげられる。代表的なものとしては、分子中にアクリロイル基を有する紫外線硬化型樹脂であり、エポキシアクリレート系、ウレタンアクリレート系、ポリエステルアクリレート系、ポリオールアクリレート系のオリゴマー、ポリマーと单官能・2官能・あるいは多官能重合性（メタ）アクリル系モノマー、例えばテトラヒドロフルフリルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピルアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリプロピレングリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリトリートルトリニアクリレート、ペンタエリトリートルテトラアクリレートなどのモノマー、オリゴマー、ポリマーなどの混合物が使用される。なお、光硬化性樹脂には、通常配合される光重合開始剤（必要であれば、光重合促進剤を併用する）を通常使用される量で配合してもよい。

【0102】

また、熱硬化性樹脂としては、例えば、トリアジン樹脂、ビスマレイミド・トリアジン(BT)樹脂等のトリアジン系樹脂、熱硬化変性を施した熱硬化性ポリフェニレンエーテル系樹脂、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂等を挙げることができるが、本発明の組成物には、特に、グリシジルエーテル型耐熱性多官能エポキシ樹脂に硬化剤としてフェノール樹脂の変性や触媒の選択により熱時低弾性化の図られた樹脂組成物を使用するのが望ましい。本発明では、これら熱硬化性樹脂の中から1種を単独で使用してもよく、又は2種以上を併用してもよい。

【0103】

本発明では、熱可塑性樹脂及び熱硬化性樹脂を併用することができる。この場合、例えば熱硬化性樹脂の硬化物を分散した熱可塑性樹脂の形態で用いてもよいし、熱可塑性樹脂を分散した熱硬化性樹脂の形態で用いてもよい。

【0104】

上記例示の熱可塑性樹脂及び熱硬化性樹脂とナノスケールカーボンチューブとからなる樹脂組成物は、低比誘電率、低誘電正接、高耐熱性、高機械的強度を有する電子部品を与える。

【0105】

上記の熱可塑性樹脂の中でも、特に、ポリフェニレンサルファイド樹脂、芳香族ポリサルホン系樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリエーテルケトン系樹脂、ポリエーテルニトロル樹脂、サーモトロピック液晶ポリエステル樹脂、エチレン/テトラフルオロエチレンコポリマー、テトラフルオロエチレン/ヘキサフルオロプロピレンコポリマー、テトラフルオロエチレン/パーフルオロアルコキシビニルエーテルコポリマー等の熱溶融性フッ素樹脂、熱可塑性ポリイミド樹脂等が好ましい。

【0106】

また、上記熱硬化性樹脂の中でも、特にトリアジン樹脂、ビスマレイミド・トリアジン(BT)樹脂等のトリアジン系樹脂、熱硬化変性を施した熱硬化性ポリフェニレンエーテル系樹脂、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂が好ましい。

【0107】樹脂組成物

本発明の樹脂組成物は、前記樹脂と前記ナノスケールカーボンチューブとを含有するものである。

【0108】

本発明の樹脂組成物は、ナノスケールカーボンチューブの添加量が、樹脂を基準として0.001～0.4重量%の割合であることを特徴としている。このように極微量のナノスケールカーボンチューブの添加により、GHz帯域における誘電正接を低減するメカニズムは現在不明であるが、極微量のナノスケールカーボンチューブが均一分散することにより、樹脂に含まれる極性基が誘電分極によって生じた双極子の電界変化をナノスケールカーボンチューブが物理的に相殺するためと考えられる。ナノスケールカーボンチューブの配合量が、0.001重量%以下ではその効果が薄れ、0.4重量%以上ではかえって誘電正接が上昇してしまう。

【0109】

ナノスケールカーボンチューブの添加量は、樹脂に対して、0.001～0.3重量%であるのが好ましい。ナノスケールカーボンチューブの添加量を、樹脂に対して0.001～0.2重量%、特に0.001～0.1重量%にするのがより好ましい。

【0110】

なお、本発明で使用する樹脂が光重合性樹脂である場合、ナノスケールカーボンチューブの添加量は、(a)光重合性の樹脂成分(オリゴマー、モノマー等)の重量、及び、(b)該光重合性樹脂の硬化に使用される光重合開始剤の重量(及び光重合促進剤を使用した場合は、光重合促進剤の重量を加える)の合計重量を基準とするものとする。例えば、樹脂として、紫外線硬化性アクリル樹脂を使用する場合は、(a)該紫外線硬化性アクリル樹脂の重量と、(b)その硬化に使用される光重合開始剤の重量(及び必要に応じて使用される光重合促進剤の重量)との合計重量に対して、ナノスケールカーボンチューブの添加量を前記の0.001～0.4重量%の範囲とする。

【0111】

本発明の樹脂組成物には、必要に応じて、本発明の効果を損ねない範囲で、この分野で使用されている酸化防止剤などの各種の添加剤を添加することもできる。

【0112】

本発明の組成物は、上記樹脂、ナノスケールカーボンチューブ及び必要に応じて上記添

加剤を混合することにより得られる。混合方法としては、公知の方法が使用でき、例えば、セラミック3本ロール、ペイントシェーカー、遊星ミル等を使用する方法が採用できる。

【0113】

電子部品

本発明の組成物は、使用する樹脂を選択することにより、低比誘電率、低誘電正接、高耐熱性及び高機械的強度を具備し、電気・電子機器の回路基板材料、特にGHz帯域用の回路基板材料として好適に使用できる。特に、各種特性（誘電特性、熱的特性、化学的特性、機械的特性）を改善した樹脂が持つ特性を劣化させることなく、GHz帯域で誘電正接の増大を抑えるので、樹脂の選択性を増大させることができる。

【0114】

本発明の樹脂組成物は、具体的には、例えば、衛星放送関連機器等に代表される高周波機器や情報処理機器のプリント回路基板材料として極めて好適に使用できる。更に本発明の樹脂組成物は、例えば、チップキャリアやピングリッドアレイ等の半導体パッケージの分野、抵抗器、スイッチ、コンデンサ、フォトセンサ等のベース部品からICソケットやコネクタ等の機構部品に至るまで、幅広い範囲で応用可能である。また、電子レンジ用の容器類にも使用が可能である。本発明の樹脂組成物は、特に、上記のような回路基板、半導体層間絶縁膜、アンテナ部品等の製造用樹脂組成物として有用である。

【0115】

これら電子部品は公知の方法により製造できる。例えば、プリント回路基板は、本発明組成物を板状に成形し、必要に応じて、その表面にめっき操作等により銅等の金属皮膜を形成し、常法に従って回路を形成することにより得られる。

【0116】

本発明組成物の成形も、公知の成形方法、例えば、射出成形、押出成形、圧縮成型、注型成形等に従って行うことができる。

【0117】

また、本発明によれば、上記ナノスケールカーボンチューブを樹脂に0.001～0.4重量%という極めて少量添加してなる樹脂組成物から得られる電子部品は、GHz帯域において、誘電正接($\tan\delta$)が樹脂単独の場合よりも低下するか、または、樹脂単独の場合の $\tan\delta$ の上昇を抑制することができる。

【0118】

従って、本発明は、樹脂に対して0.001～0.4重量%の割合でナノスケールカーボンチューブを樹脂に配合することを特徴とする、当該樹脂から得られる電子部品のGHz帯域での $\tan\delta$ を低減乃至抑制する方法を提供するものもある。

【0119】

更に、本発明によると、上記ナノスケールカーボンチューブを樹脂に0.001～0.4重量%という極めて少量添加してなる樹脂組成物から得られる電子部品は、GHz帯域において、誘電正接($\tan\delta$)が樹脂単独の場合よりも低下するか、または、樹脂単独の場合の $\tan\delta$ の上昇を抑制することができ、一方、樹脂が本来有する比誘電率、耐熱性、機械的強度等の物性は実質上変化することなくそのまま維持される。

【0120】

従って、本発明は、樹脂に対して0.001～0.4重量%の割合でナノスケールカーボンチューブを樹脂に配合することを特徴とする当該樹脂から得られる電子部品のGHz帯域での $\tan\delta$ を樹脂単独の場合に比し低減させるが、樹脂が本来有している他の物性、例えば、誘電特性、熱的特性、化学的特性、機械的特性等（特に誘電特性）は維持する方法を提供するものもある。

【実施例】

【0121】

以下に参考例（ナノスケールカーボンチューブの製造例）、実施例及び比較例を掲げて、本発明をより詳しく説明するが、本発明はこれら実施例により限定されるものではなく、

各種の変更が可能である。

【0122】

参考例1

アモルファスナノスケールカーボンナノチューブの製造

アモルファスナノスケールカーボンナノチューブは以下に示す方法で作製した。

【0123】

60 μm × 10 mm × 10 mm の P T F E フィルムに無水塩化鉄粉末（粒径 500 μm 以下）10 mg を均一に振りかけた後、プラズマ励起した。プラズマ励起の条件は、以下の通りであった：

雰囲気 : アルゴン (A r)
内圧 : 0.01 torr
投入電力 : 300 W
R F 周波数 : 13.56 MHz。

【0124】

反応終了後、アモルファスナノスケールカーボンチューブ（外径； 10 ~ 60 nm、長さ； 5 ~ 6 μm）が形成されたことを、走査電子顕微鏡 (S E M) およびX線回折により確認した。

【0125】

また、得られたアモルファスナノスケールカーボンチューブのX線回折角度 (2θ) は 19.1 度であり、それから計算される炭素網平面間隔 (d 002) は 4.6 Å、2θ のバンドの半値幅は 8.1 度であった。

【0126】

参考例2

原料としてトルエンを用い、触媒として塩化第2鉄を用い、特開2002-338220号に記載の方法に従って反応を行うことにより、炭化鉄がナノフレークカーボンチューブのチューブ内空間部に部分的に内包された鉄-炭素複合体を含む炭素質材料を得た。

【0127】

得られた鉄-炭素複合体は、SEM観察の結果から、外径 20 ~ 100 nm、長さ 1 ~ 10 ミクロンで直線性の高いものであった。また、炭素からなる壁部の厚さは、5 ~ 40 nm であり、全長に亘って実質的に均一であった。該壁部は、TEM観察において、その炭素壁面が、入れ子状でもスクロール状でもなく、パッチワーク状（いわゆる paper mache 状ないし張り子状）になっているように見え、また、X線回折法から炭素網面間の平均距離 (d 002) が 0.34 nm 以下の黒鉛質構造を有するナノフレークカーボンチューブであることを確認した。また、X線回折、E D X により、上記本発明の鉄-炭素複合体には炭化鉄が内包されていることを確認した。

【0128】

得られた本発明の炭素質材料を構成する多数の鉄-炭素複合体を含む炭素質材料を電子顕微鏡 (TEM) で観察したところ、ナノフレークカーボンチューブの空間部（即ち、ナノフレークカーボンチューブのチューブ壁で囲まれた空間）への炭化鉄の充填率が 20 ~ 60 % の範囲の種々の充填率を有する鉄-炭素複合体が混在していた。

【0129】

該多数の鉄-炭素複合体のナノフレークカーボンチューブ内空間部への炭化鉄のTEM観察像の複数の視野を観察して算出した平均充填率は 30 % であった。また、X線回折から算出された R 値は、0.57 であった。

【0130】

実施例1～5

樹脂として、感光性アクリル樹脂（日本化薬社製 E A M - 2160）98 g、光重合開始剤（日本化薬社製 D E T X - S）1 g、光重合促進剤（日本化薬社製 E P A）1 g を混合したものを使用した。

【0131】

ナノスケールカーボンチューブとして、参考例2で得られた鉄一炭素複合体を表1に記載の割合で使用した。表1は、上記感光性アクリル樹脂、光重合開始剤、光重合促進剤の合計100重量部に対するナノスケールカーボンチューブの配合量（重量部）を示している。

【0132】

樹脂とナノスケールカーボンチューブ（鉄一炭素複合体）とを、セラミック3本ロール（ノリタケカンパニー製 NR-42A）により混合し、ナノスケールカーボンチューブを樹脂に均一分散させ、ペーストを得た。

【0133】

得られたペーストを円筒形のモールドに入れて水銀灯（500W）で紫外線（照射線量：6J/cm²）を照射し、円筒形の成形体を得た。この成形体の中央部をくりぬいて、評価用サンプルを得た。この評価用サンプルは、図5の501に示すように、同軸状加工物で、ドーナツ型の形状をしており、外径(2b)が0.7cm、内径(2a)が0.3cm、高さ(L)が0.15cmである。

【0134】

比較例1～3

鉄一炭素複合体の使用量を、上記感光性アクリル樹脂、光重合開始剤、光重合促進剤の合計に対して、0重量%、1.02重量%又は2.98重量%とした以外は実施例1～5と同様にして比較のための評価用サンプルを得た。

【0135】

実施例6

鉄一炭素複合体に代えて、参考例1で得たアモルファスナノスケールカーボンチューブを使用した以外は実施例2と同様にして評価用サンプルを得た。

【0136】

比較例4及び5

アモルファスナノスケールカーボンチューブの使用量を、上記感光性アクリル樹脂、光重合開始剤、光重合促進剤の合計に対して1.19重量%又は3.02重量%とした以外は実施例6と同様にして比較のための評価用サンプルを得た。

【0137】

実施例7

鉄一炭素複合体に代えて市販の単層カーボンナノチューブを表1に記載の割合で使用した以外は実施例1～5と同様にして評価用サンプルを得た。

【0138】

比較例6～8

単層カーボンナノチューブの量を上記感光性アクリル樹脂、光重合開始剤、光重合促進剤の合計に対して、0.50重量%、0.98重量%、3.01重量%とする以外は実施例1と同様にして比較のための評価用サンプルを得た。

【0139】

【表1】

表1

	アクリル樹脂、光重合開始剤及び光重合促進剤の合計 (重量部)	ナノスケールカーボンチューブ(重量部)		
		鉄一炭素複合体 (参考例2)	アモルファスナノスケールカーボンチューブ (参考例1)	カーボンナノチューブ (市販品)
比較例1	100	0	—	—
実施例1	100	0.005	—	—
実施例2	100	0.01	—	—
実施例3	100	0.03	—	—
実施例4	100	0.05	—	—
実施例5	100	0.10	—	—
比較例2	100	1.02	—	—
比較例3	100	2.98	—	—
実施例6	100	—	0.01	—
比較例4	100	—	1.19	—
比較例5	100	—	3.02	—
実施例7	100	—	—	0.02
比較例6	100	—	—	0.50
比較例7	100	—	—	0.98
比較例8	100	—	—	3.01

【0140】

試験例1

前記実施例1～7及び比較例1～8で得られた評価用サンプルを、黒川悟ら、京都府中小企業総合センター技報、2002、No.30に記載の方法に従い、GHz帯域での $\tan\delta$ 及び比誘電率を測定した。

【0141】

即ち、APC7mm規格の同軸コネクタの同軸状に加工した評価用サンプルを、図5に示すようにアウターコンダクタ503に挿入し、S₁₁、S₂₁の2つのSパラメータを測定することにより複素誘電率を求める方法によりおこなった。測定は、ベクトルネットワークアナライザにより、APC7mm規格の同軸コネクタの同軸状に加工した被測定材料を挿入し、S₁₁、S₂₁の2つのSパラメータを測定することにより複素誘電率を求める方法により行なった。

【0142】

比較例1（アクリル樹脂単独）、実施例2、実施例3及び比較例3で得られた評価用サンプルの $\tan\delta$ の測定結果を、図6に示す。また、比較例1、実施例2及び実施例3で得られた評価用サンプルの比誘電率の測定結果を、図7に示す。図6及び図7から判るように、鉄一炭素複合体を含有しない樹脂単独から得られた評価用サンプル（比較例1）に比べ、特定量の鉄一炭素複合体を含有する樹脂組成物から得られた評価用サンプルは、誘電率（ $\tan\delta$ ）の上昇が抑制されているが、比誘電率は変化しないことが判る。

【0143】

比較例1、実施例6及び比較例4で得られた評価用サンプルの $\tan\delta$ の測定結果を図8に示す。図8から判るように、アモルファスナノスケールカーボンチューブを約0.01重量%含有する実施例6の評価用サンプルは、樹脂単独からなる評価用サンプル（比較例1）又はアモルファスナノスケールカーボンチューブを1重量%を越えて含有する評価用サンプル（比較例4）に比べて、 $\tan\delta$ の上昇が抑制されている。

【0144】

また、比較例1及び実施例7で得られた評価用サンプルのtan δ の測定結果を図9に示す。図9から判るように、カーボンナノチューブを約0.02重量%含有する実施例7の評価用サンプルは、樹脂単独からなる評価用サンプル（比較例1）に比べて、tan δ の上昇が抑制されている。

【0145】

更に、各実施例及び各比較例で得られた評価用サンプルの1GHz、5GHz及び10GHzにおけるtan δ 及び比誘電率の測定結果を表2に示す。

【0146】

【表2】

表2

	Tan δ			比誘電率		
	1GHz	5GHz	10GHz	1GHz	5GHz	10GHz
比較例1	0.05	0.06	0.08	3.3	3.1	3.1
実施例1	0.04	0.04	0.04	3.3	3.2	3.1
実施例2	0.04	0.04	0.04	3.4	3.2	3.2
実施例3	0.05	0.05	0.06	3.4	3.2	3.2
実施例4	0.04	0.04	0.05	3.4	3.2	3.2
実施例5	0.05	0.05	0.07	3.4	3.3	3.2
比較例2	0.08	0.07	0.09	3.5	3.3	3.3
比較例3	0.06	0.07	0.09	4.1	4.0	3.9
実施例6	0.04	0.04	0.04	3.2	3.2	3.2
比較例4	0.06	0.08	0.10	4.9	4.4	4.3
比較例5	0.06	0.11	0.15	8.3	7.8	7.3
実施例7	0.05	0.04	0.06	3.3	3.2	3.2
比較例7	0.22	0.18	0.17	5.6	4.6	4.2
比較例8	0.25	0.23	0.26	7.9	6.1	5.8
比較例9	0.21	0.23	0.26	10.7	9.0	8.2

【0147】

上記表2から、ナノスケールカーボンチューブを特定量含有する本発明の樹脂組成物を用いて得られる電子部品は、GHz帯域、特に1～10GHzの周波数範囲において、ナノスケールカーボンチューブを含有しない樹脂そのもの（比較例1）から得られる電子部品と比べて、tan δ の上昇が抑制されているが、樹脂が本来有する物性（比誘電率）は殆ど劣化されることなく、ほぼ維持されることが判る。

【図面の簡単な説明】

【0148】

【図1】特開2002-338220号の実施例1で得られた炭素質材料を構成する鉄-炭素複合体1本の電子顕微鏡(TEM)写真である。

【図2】特開2002-338220号の実施例1で得られた炭素質材料における鉄-炭素複合体の存在状態を示す電子顕微鏡(TEM)写真である。

【図3】特開2002-338220号の実施例1で得られた鉄-炭素複合体1本を輪切状にした電子顕微鏡(TEM)写真である。尚、図3の写真中に示されている黒三角(▲)は、組成分析のためのEDX測定ポイントを示している。

【図4】カーボンチューブのTEM像の模式図を示し、(a-1)は、円柱状のナノフレークカーボンチューブのTEM像の模式図であり、(a-2)は入れ子構造の多層カーボンナノチューブのTEM像の模式図である。

【図5】各実施例及び各比較例で製造した評価用サンプルの形状を示す斜視図である

【図6】比較例1、実施例2、実施例3及び比較例3で得られた評価用サンプルのtan δ の測定結果を示すグラフである。

【図7】比較例1、実施例2及び実施例3で得られた評価用サンプルの比誘電率の測定結果を示すグラフである。

【図8】比較例1、実施例6及び比較例4で得られた評価用サンプルのtan δ の測定結果を示すグラフである。

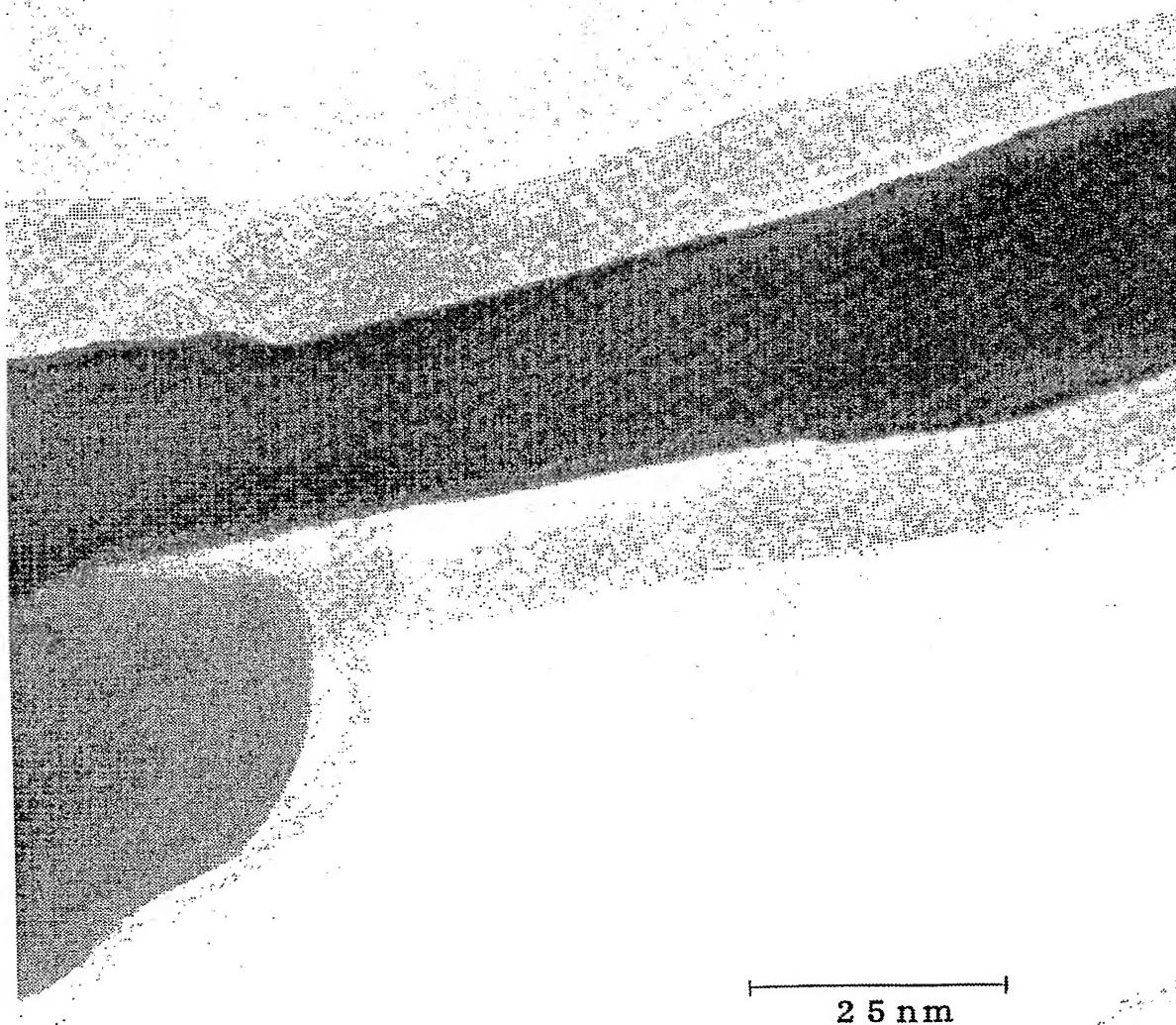
【図9】比較例1及び実施例7で得られた評価用サンプルのtan δ の測定結果を示すグラフである。

【符号の説明】

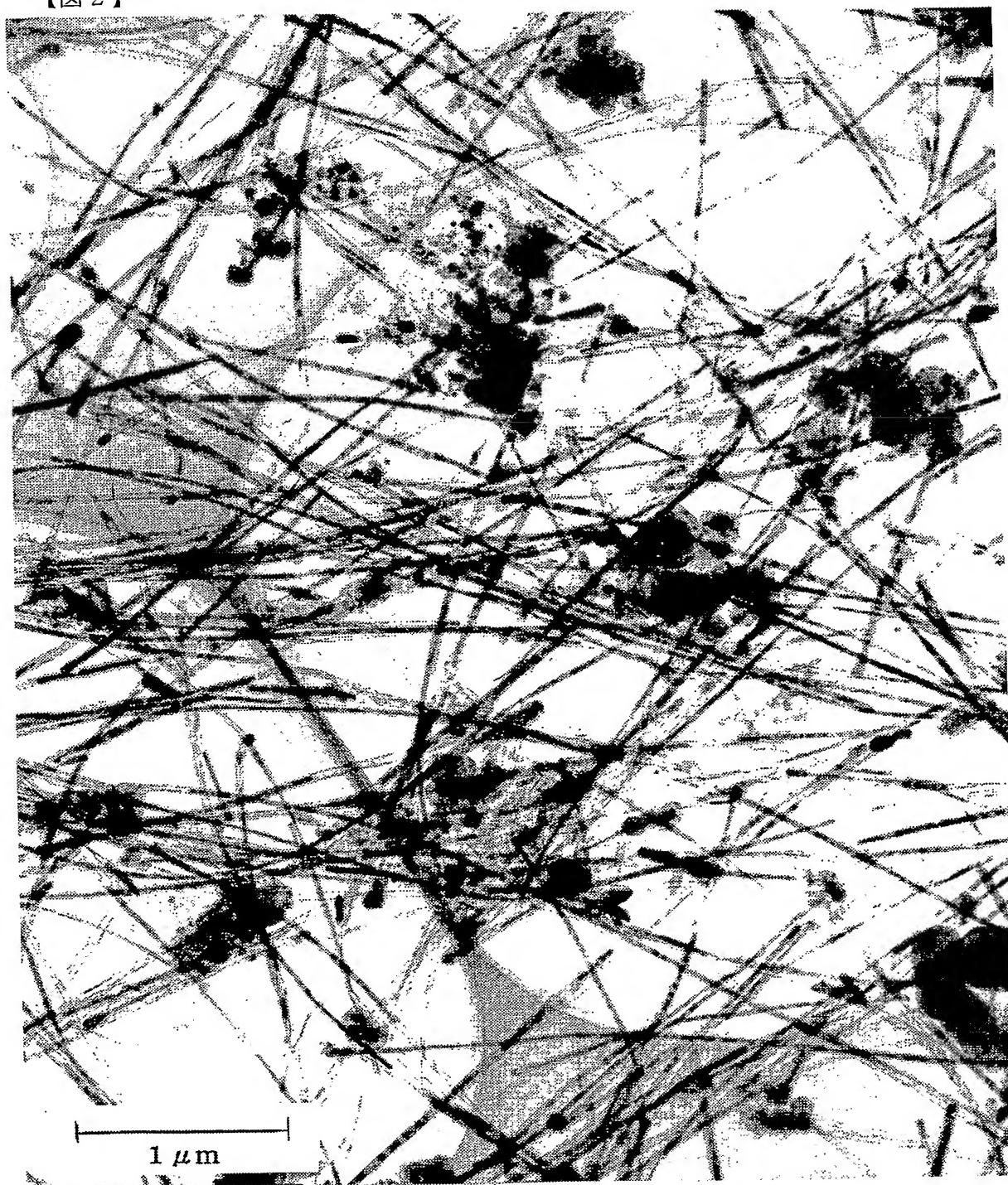
【0149】

- | | |
|-----|---|
| 100 | ナノフレークカーボンチューブの長手方向のTEM像 |
| 110 | 略直線状のグラフェンシート像 |
| 200 | ナノフレークカーボンチューブの長手方向にはぼ垂直な断面のTEM像 |
| 210 | 弧状グラフェンシート像 |
| 300 | 入れ子構造の多層カーボンナノチューブの長手方向の全長にわたって連続する直線状グラフェンシート像 |
| 400 | 入れ子構造の多層カーボンナノチューブの長手方向に垂直な断面のTEM像 |
| 501 | 評価用サンプル |
| 502 | インナーコンダクタ |
| 503 | アウターコンダクタ |

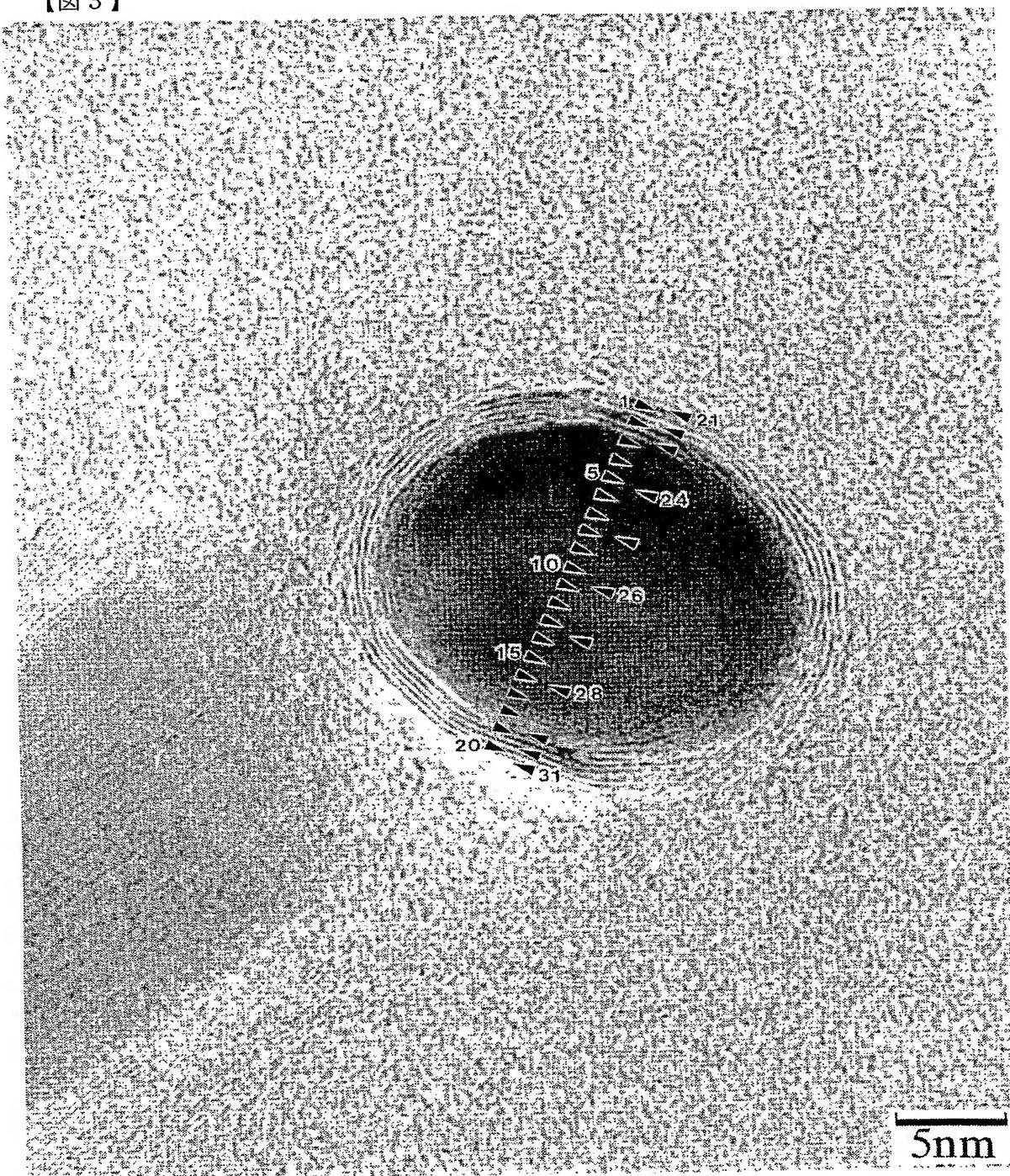
【書類名】 図面
【図1】



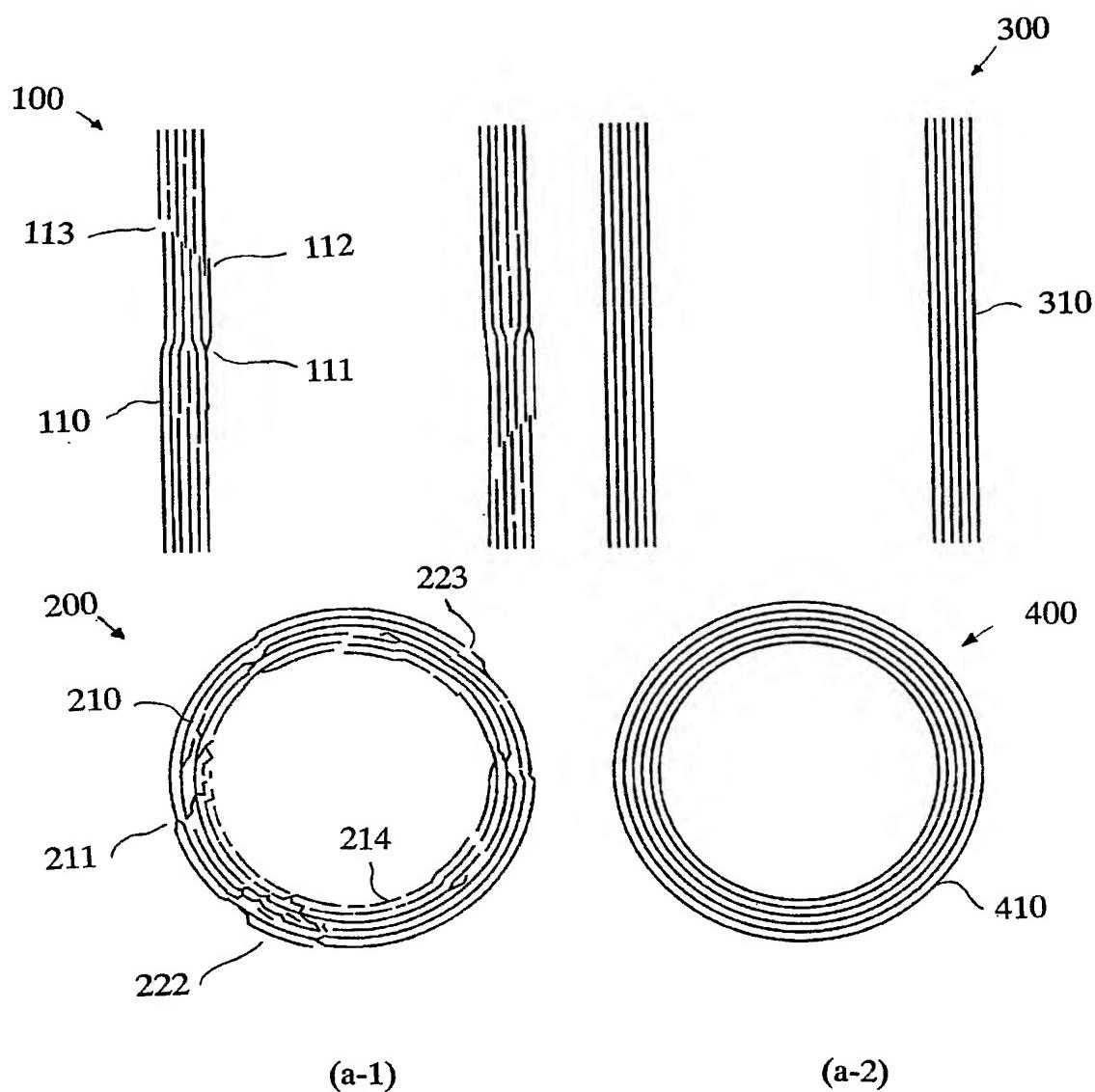
【図2】



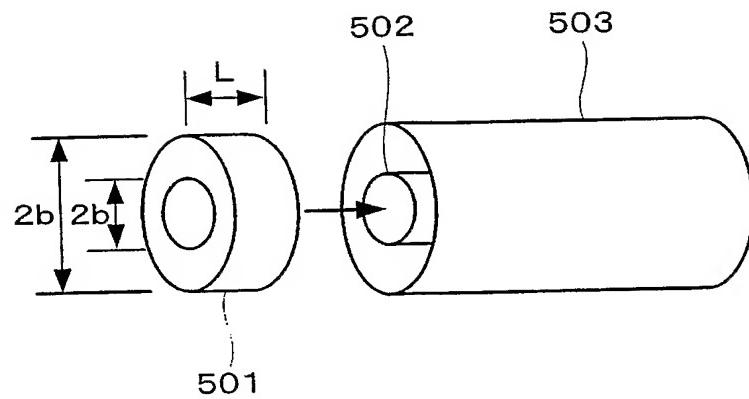
【図3】



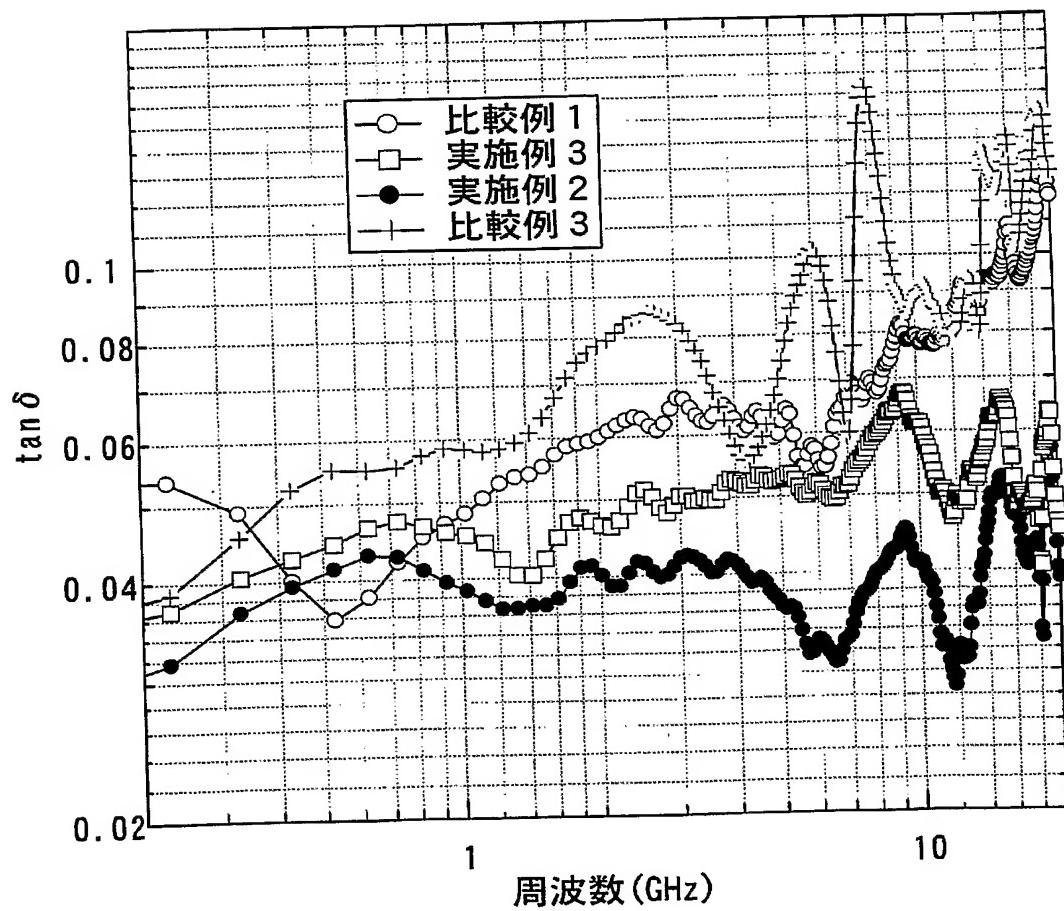
【図4】



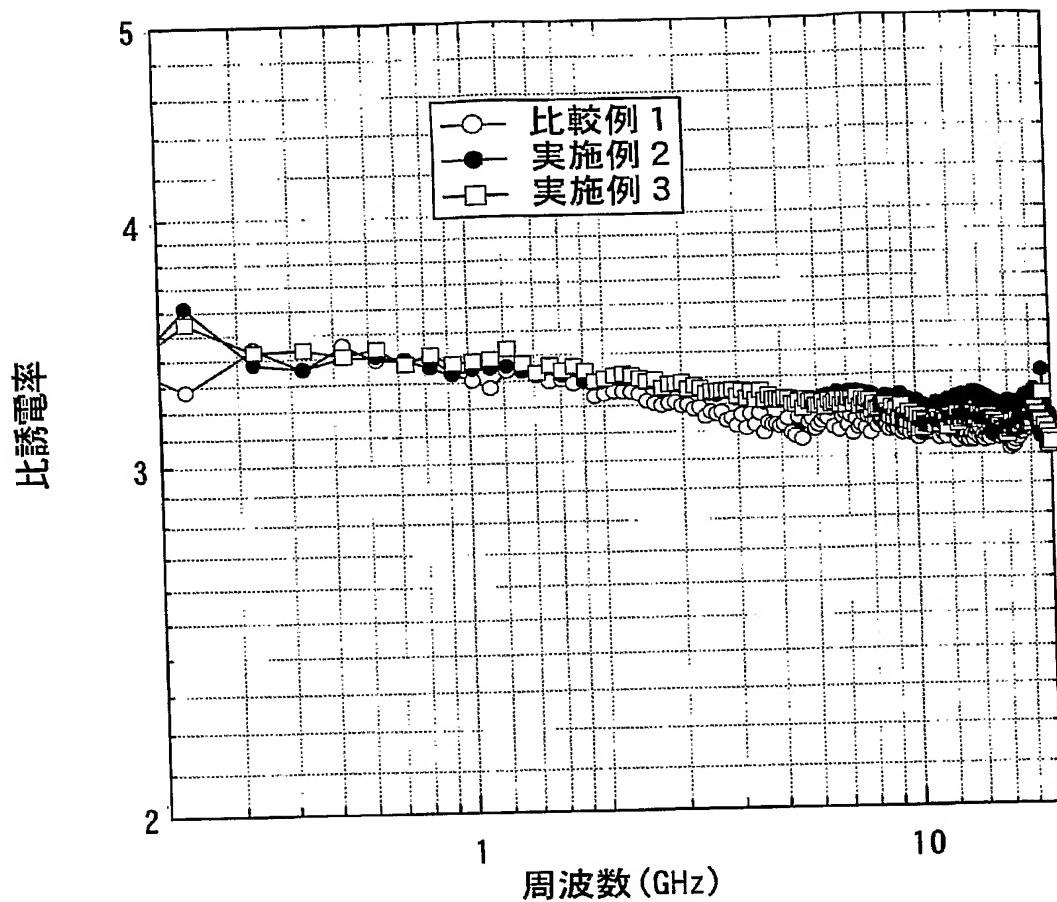
【図5】



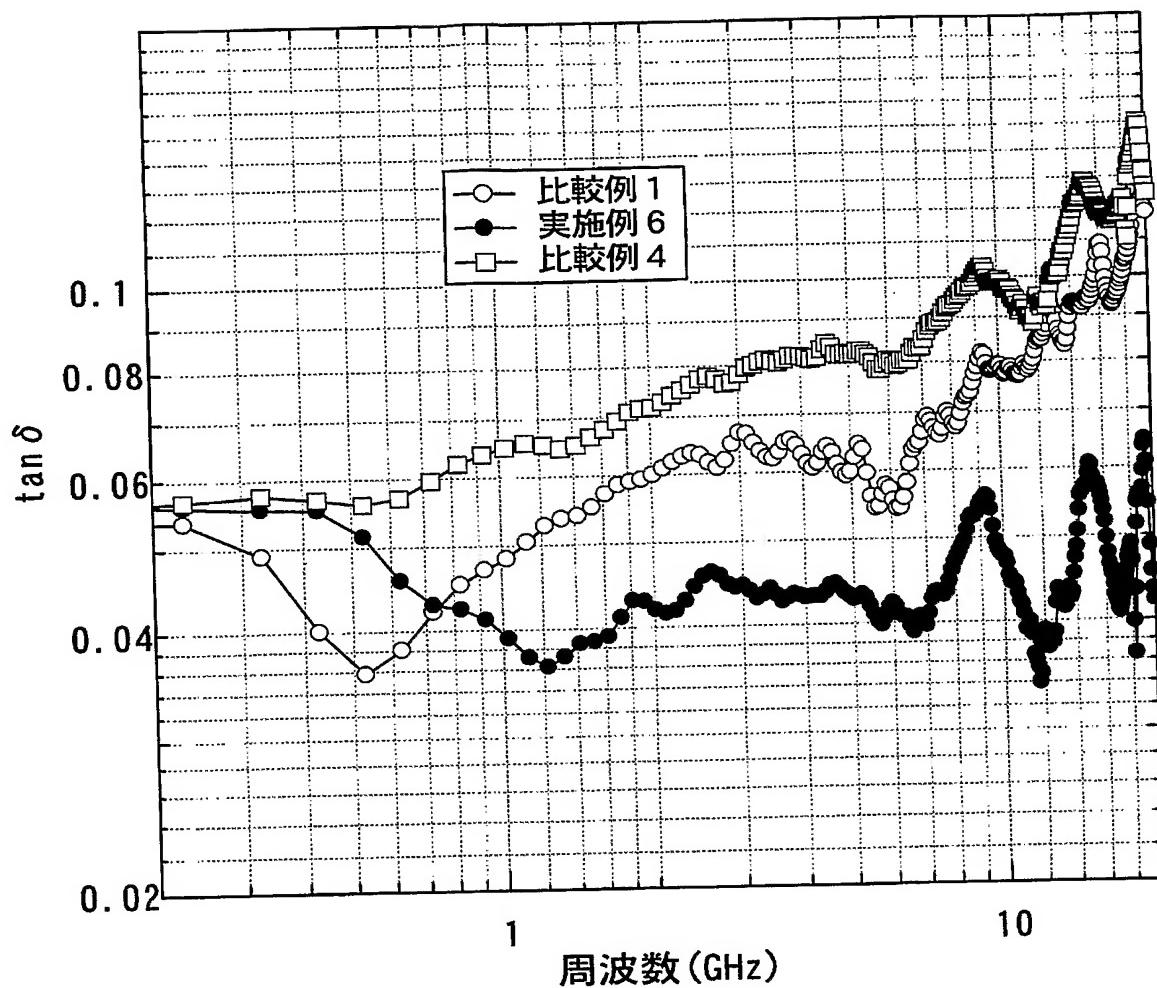
【図6】



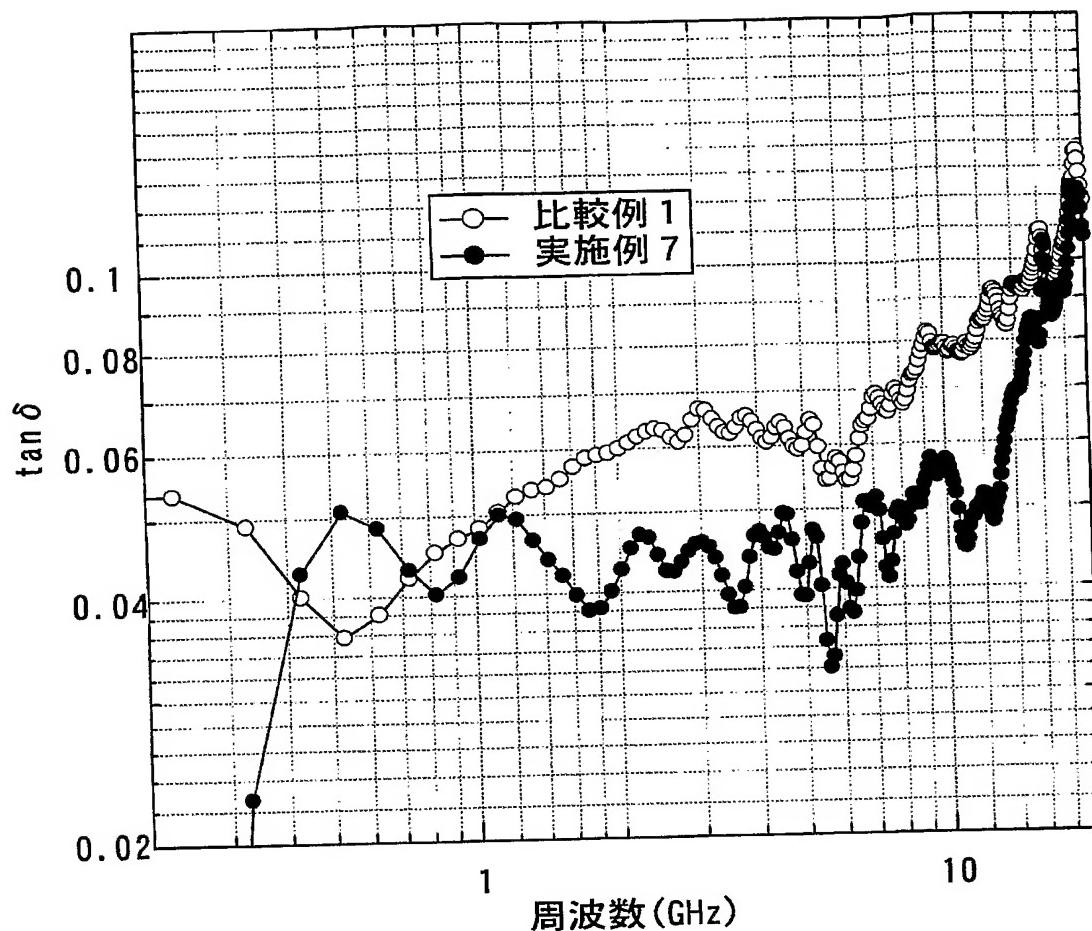
【図 7】



【図8】



【図9】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 樹脂に少量添加するだけで、G H z 帯域における誘電損失（ないし $\tan \delta$ ）を低減させることができる添加剤を開発し、種々の要請に柔軟に応えることができる電子部品用樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 熱可塑性樹脂及び熱硬化性樹脂から選ばれた少なくとも1種の樹脂及びナノスケールカーボンチューブを含有し、ナノスケールカーボンチューブが上記樹脂を基準として0.001～0.4重量%の割合で含有されていることを特徴とするG H z 帯域電子部品用樹脂組成物、及び該樹脂組成物から得られる電子部品。

【選択図】なし

特願 2004-027996

出願人履歴情報

識別番号

[000000284]

1. 変更年月日

[変更理由]

住 所

氏 名

1990年 8月 8日

新規登録

大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号

大阪瓦斯株式会社